SIC CARRIER

碳化矽承載盤

Silicon Carbide (SiC) Carrier

碳化矽承載盤（SiC 承載盤）是晶圓解鍵合時托住晶圓的透氣載盤，用在下蠟機與晶圓分離設備。適合三五族與第三代半導體這類薄、脆的晶圓製程。



孔隙率 Porosity	尺寸 Dimension	密度 Density
25 ± 2 %	Ø4 ~ 8"	3.2 g/cm³

FEATURES

產品特點

隨著晶片越做越薄，加上 SiC 等硬度高、較脆、容易碎裂的化合物半導體普及，晶圓製程中必須把脆弱的晶圓放在其他臨時的承載晶圓 / 基板上加工，完成後再將兩者分離。

III-V 族晶圓經背面研磨減薄後，進行微影、金屬化、蝕刻等工藝；之後使用基座加熱到所需溫度，讓鍵合蠟溶解，再由上下真空吸盤建立真空吸力，以步進馬達驅動向前移動，使承載盤與晶圓分離。

暫時鍵合（Bond）製程使用的玻璃承載盤，SAWA 也可一併供應，歡迎與碳化矽承載盤一起詢價。

透氣與晶圓分離 Porosity 25 ± 2%
碳化矽透氣承載盤，用於解鍵合（Debond）製程。

SPECIFICATION

產品規格

材質 Material	碳化矽（SiC）
尺寸 Dimension	Ø4 ~ 8"，厚度 0.7 ~ 1 mm（公差 ± 0.1 mm）
孔隙率 Porosity	25 ± 2%
密度 Density	3.2 g/cm³
平面度 Flatness	依需求客製 / 洽詢

孔隙率、密度等材料特性取自 Ø96×1 mm 承載盤規格表；其他尺寸請來信洽詢。

APPLICATIONS

應用範圍

晶圓分離
解鍵合時托住晶圓的透氣載盤。

下蠟機
用於下蠟機承載晶圓。

應用領域

三五族晶圓代工　第三代半導體晶圓代工

PHOTOS

產品照片



實品

官網產品頁有介紹影片與可旋轉的 3D 剖視圖：www.sawa-corp.com/products/sic-carrier/

告訴我們尺寸與製程，我們回報價。

03-5501300
vic@sawa-corp.com